

性能特点：

- 频带：DC~4GHz
- 插入损耗：0.6dB
- 隔离度：48dB
- 控制电压：0/-5V
- 芯片尺寸：0.90mm×0.92mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW20004 是一款 GaAs MMIC 反射式单刀双掷开关芯片，其频率范围覆盖 DC~4GHz，整个带内插损小于 0.6dB，隔离度大于 48dB，HH-SW20004 采用 0/-5V 供电。

电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_s=0/-5\text{V}$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC~4			GHz
插入损耗	-	0.6	-	dB
隔离度	48	-	-	dB
输入电压驻波比	-	1.5	-	-
输出电压驻波比	-	1.5	-	-

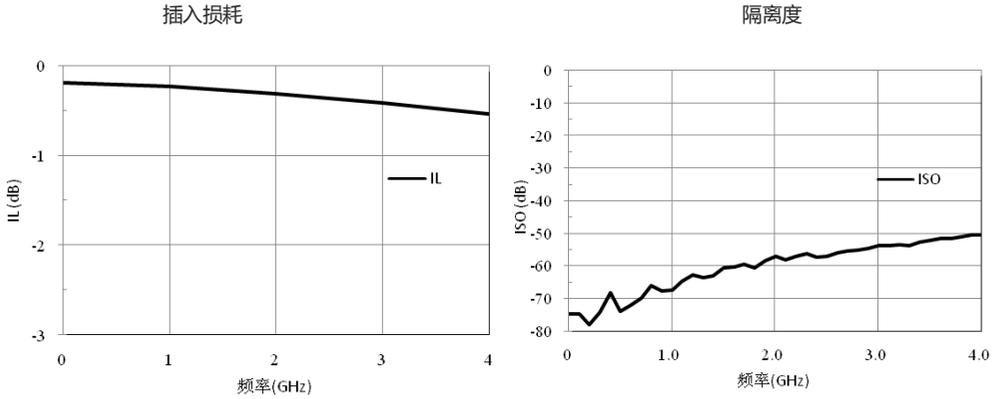
使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

输入功率	+30dBm
控制电压	-8~+1V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

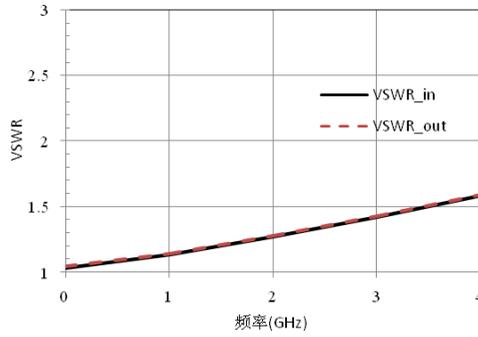
开关真值表：

A	B	IN-1	IN-2
-5	0	ON	OFF
-0	-5	OFF	ON

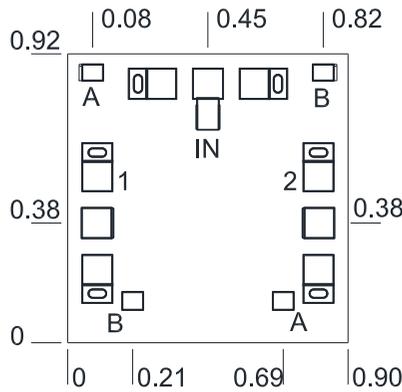
典型曲线：



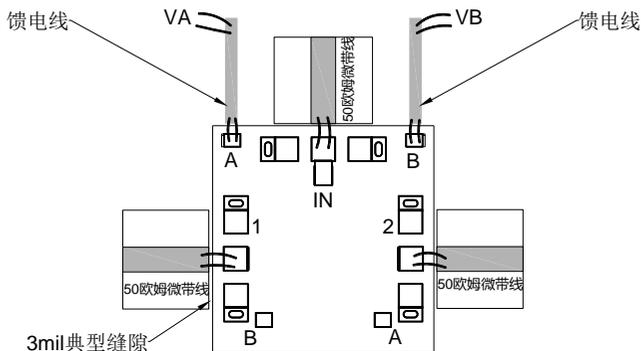
输入/输出电压驻波比



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出无隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。